附件：

讨论的标准项目

| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 主编单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 |
|  | 国标委发[2021]41号20214648-T-469 | 高纯镓 | 有研国晶辉新材料有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]23号20213238-T-469 | 碳化硅晶体材料缺陷图谱 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]23号20213239-T-469 | 蓝宝石图形化衬底片 | 广东中图半导体科技股份有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]28号20214216-T-469 | III族氮化物半导体材料中位错成像的测试 透射电子显微镜法 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]41号20214653-T-469 | 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第1部分：缺陷分类 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]41号20214649-T-469 | 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第2部分：缺陷的光学检测方法 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]41号20214654-T-469 | 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第3部分：缺陷的光致发光检测方法 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 讨论 |
| 第二组 |
|  | 国标委发[2021]41号20214650-T-469 | 硅中代位碳含量的红外吸收测试方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]41号20214647-T-469 | 半导体晶片近边缘几何形态评价 第1部分：高度径向二阶导数法（ZDD） | 山东有研半导体材料有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2022]17号20220133-T-469 | 埋层硅外延片 | 南京国盛电子有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2021]291号2021-1758T-YS | 二氧化碳排放核算与报告要求 多晶硅企业 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2021]291号2021-1759T-YS | 多晶硅企业能源管理中心技术规范 | 新特能源股份有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2021]291号2021-1760T-YS | 多晶硅行业能源管理体系实施指南 | 新特能源股份有限公司 | 讨论 |